光の広堤

近年のマイクロマシニング技術のめまぐるしい発展に伴い、ナノメートル精度の加工が可能となり、 加工形状の深さや形状をコントロールした製品の製作が可能となってきた.さらに、マスクを用いたフォトリソグラフィーやマスクを用いない電子線リソグラフィーとエッチングの組み合わせにより、矩形状、三次元形状や非球面を含むマイクロレンズの加工、光の波長より短い周期をもつサブ波長格子 (SWS: subwavelength structure)の加工も可能になってきた.

SWS は、光の波長より小さい形状を製作するこ とにより、光の回折現象を用いずに、ある屈折率を 有する一様な媒質を形成することが可能で、その屈 折率は構造やそれを構成する物質の屈折率で決ま る。この形状に方向性をもたせると、構造性複屈折 とよばれる異方性が生じる。また屈折率分布を材質 表面にもたせることができる。現在これらの特性を 用いて、反射防止構造、偏光分離素子、波長選択フ ィルター等、さまざまな光学素子が研究され実用化 されつつある。本稿では、SWSを用いた反射防止 板、偏光ビームスプリッターを例に、設計例や光学 特性について述べる¹⁻³.

SWS を用いた光学素子の設計には、厳密な電磁 界解法の Moharam が提案した RCWA (rigorous coupled wave analysis) 法がある. RCWA 法は周 期構造を厚み方向の層に分割して、エッジ角度が傾 いていても容易に取り扱うことができ、加工形状に

電子線レジスト

金型

MMM

(1) 電子線レジストのコーティング

(2)電子線描画

(3)現像

(4)ドライエッチング

(5)レジスト除去

非常に近い状態での解析ができる。市販のソフトで RCWAのアルゴリズムを利用したソフトもある が、ナルックスでは、大阪府立大の菊田助教授より 提供されたプログラムにμ-GAを組み込むことに より自動に形状を最適化するソフトを開発し、 SWSを用いた光学素子を製作した。

図1にSWSの製作工程を示す.基板には射出成 形できる金型材料としてNi合金を用い,この基板 上に電子線レジストをコーティングし電子線描画装 置でパターニングを行う.現像後ドライエッチング によりエッチングし,残ったレジストを有機アルカ リ液にて除去するとSWSの形状ができる.電子線 描画の露光時間,露光方法やエッチングの加工条件 の調整により,優れた反射防止構造や偏光ビームス プリッターを製作することができた.

図2は反射防止構造の基準設計形状を表す.でき るだけ平面部分をなくす構造として千鳥配列を採用 した.格子の高さは、射出成形の転写率が80% (深さ約284 nm)でも十分光学性能を発揮できるよ うに、格子断面形状を工夫することにより、透過率 を上げることができた。図3は、設計形状から射出 成形し全体に転写率が変わったときの波長に対する 透過率特性をシミュレーションした結果である.

図4は電子線レジストに電子線描画し、ドライエ ッチングしてできた金型表面に形成された反射防止 構造を示し、図5は射出成形された成形品の反射防 止構造を示す.成形品の転写率は約80%にとどま っている.この成形品の反射率特性と透過率特性を 分光計で測定した結果を図6と図7に示す.可視の 波長帯域で反射率が0.5~1.0%,透過率で97~ 98.5%.となった.これらの結果から、一般的な



図2 反射防止構造の基本設計形状.

35巻4号(2006)





図4 金型の反射防止の SEM 写真.



図5 成形品の反射防止の SEM 写真.

AR コートとよばれる蒸着膜特性より波長依存性の ない反射防止特性が得られたといえる。利用用途と して,携帯端末等のディスプレイの反射防止や CCD センサーのカバーガラス等,反射率低減の蒸 着膜が必要な光学部品に適用できる。また,透過率 特性が上がることより,発光源の部品等に加工でき れば,発光輝度の上昇にもつながると考えられる。

金型作製の際に電子線描画装置を用いて加工して いるため、大面積への展開は加工速度の問題から難 しいと思われ、蒸着しにくい形状箇所への加工が有 用である。図8は、実際に回折格子上に反射防止構



図8 回折格子上に付けた反射防止構造.

造を付けた例であり、従来の蒸着では膜厚のばらつ きや膜特性によって最終製品の特性が変化しやすい が、あらかじめ金型に加工しておくと、二次要因の 不良を削減できる効果がある。

(ナルックス(株) 岡田 真)

文 献

- 1) 北川清一郎ほか: O plus E, 26 (2004) 1058-1063.
- 2) 岡田 真: JETI, 6月臨時増刊号 (2005) 65-67.
- 3) 岡田 真:光アライアンス, 16 (2005) No. 10.